








	<h2>SI7858ADP-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7858ADP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7858ADP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 44817 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7858ADP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	44817 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 20A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 29A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5700pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7858ADP-T1-E3CT


SI7858ADP-T1-E3 ist neu im Original. Suche SI7858ADP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7858ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7858ADP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI7856DP-T1-GE3 VB SI7856DP-T1-GE3 VB	 SI7856DP-T1-E3 VISHAY SI7856DP-T1-E3 VISHAY	 SI7856DP-T1 VISHAY SI7856DP-T1 VISHAY	 SI7858ADP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8
 SI7858BDP-T1-E3 VISHAY SI7858BDP-T1-E3 VISHAY	 SI7858ADP VISHAY SI7858ADP VISHAY	 SI7858BDP VB SI7858BDP VB	 SI7858ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8

heiße Teile

Mehr

 SI7848DP-T1-GE3	 SI7850DP	 SI7850DP-T1-E3	 SI7850DP-T1-E3	 SI7850DP-T1-GE3
 SI7850DP-T1-GE3	 SI7852ADP	 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-GE3
 SI7852ADP-T1-GE3	 SI7852DP	 SI7852DP-T1-E3	 SI7852DP-T1-E3	 SI7852DP-T1-GE3
 SI7852DP-T1-GE3	 SI7856ADP	 SI7856ADP-T1-E3	 SI7856ADP-T1-E3	 SI7856ADP-T1-GE3
 SI7856ADP-T1-GE3	 SI7856DP-T1	 SI7856DP-T1-GE3	 SI7856DP-T1-E3	 SI7858ADP
 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858BDP	 SI7858BDP-T1-E3
 SI7860ADP	 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-GE3	 SI7860ADP-T1-GE3
 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860DP	 SI7860DP-T1	 SI7860DP-T1-E3	 SI7860DP-T1-E3
 SI7860DP-T1-GE3	 SI7860DP-T1-GE3	 SI7860DP-T1-E3	 SI7862ADP	 SI7862ADP-T1-E3
 SI7862ADP-T1-E3	 SI7862ADP-T1-GE3	 SI7862ADP-T1-GE3	 SI7862DP	 SI7862DP-T1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

